

PNPエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波電力増幅および低速度スイッチング用
工業用

PNP Silicon Epitaxial Transistor
Low Frequency Power Amplifier, Low Speed Switching
Industrial Use

特長 / FEATURES

- 絶縁板および絶縁ブッシングが不要なモールドパッケージです。
- 小形外形に比べ電流容量が大きい。 $I_{C(DC)} = 7\text{ A}$
- コレクタ飽和電圧が低い。 $V_{CE(sat)} = -0.5\text{ V MAX. (@ } -5\text{ A)}$
- ランプドライバ、インダクタンスドライバの用途に最適です。
- コンプリメンタリトランジスタ：2SD1588

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-60	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-7.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	-7.0	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-15	A
ベース電流(直流)	$I_{B(DC)}$	-3.5	A
全損失	$P_{T(T_c=25^\circ\text{C})}$	30	W
全損失	$P_{T(T_a=25^\circ\text{C})}$	2.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

* $PW \leq 300\ \mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 10\%$

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -60\text{ V}$, $I_E = 0$			-10	μA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5.0\text{ V}$, $I_C = 0$			-10	μA
直流電流増幅率	h_{FE1} **	$V_{CE} = -1.0\text{ V}$, $I_C = -3\text{ A}$	40		200	
直流電流増幅率	h_{FE2} **	$V_{CE} = -1.0\text{ V}$, $I_C = -5\text{ A}$	20			
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ **	$I_C = -5\text{ A}$, $I_B = -0.5\text{ A}$			-0.5	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$ **	$I_C = -5\text{ A}$, $I_B = -0.5\text{ A}$			-1.5	V

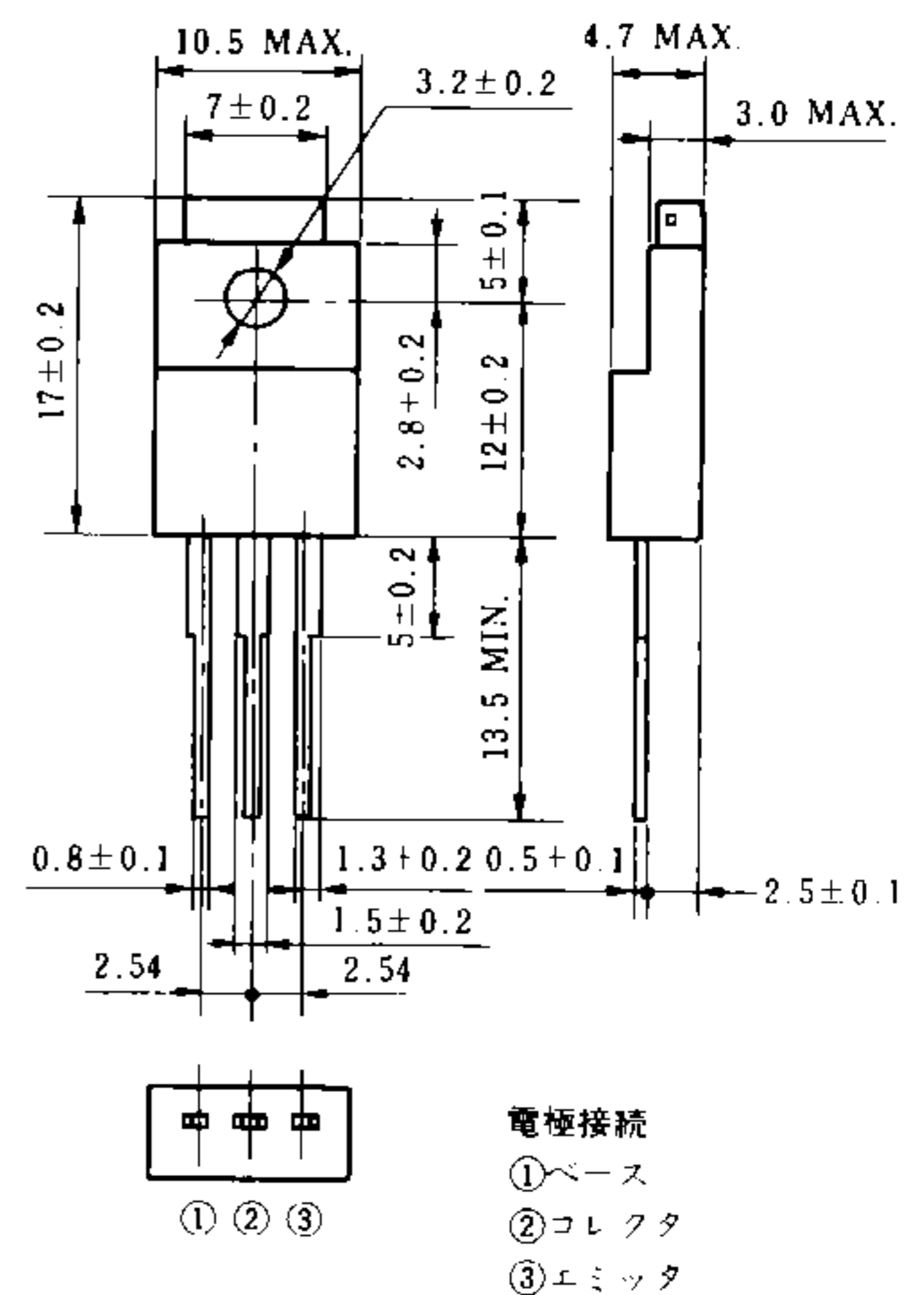
**パルス測定 $PW \leq 350\ \mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$ / Pulsed

h_{FE} 規格区分

捺印	M	L	K
h_{FE1}	40~80	60~120	100~200

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS

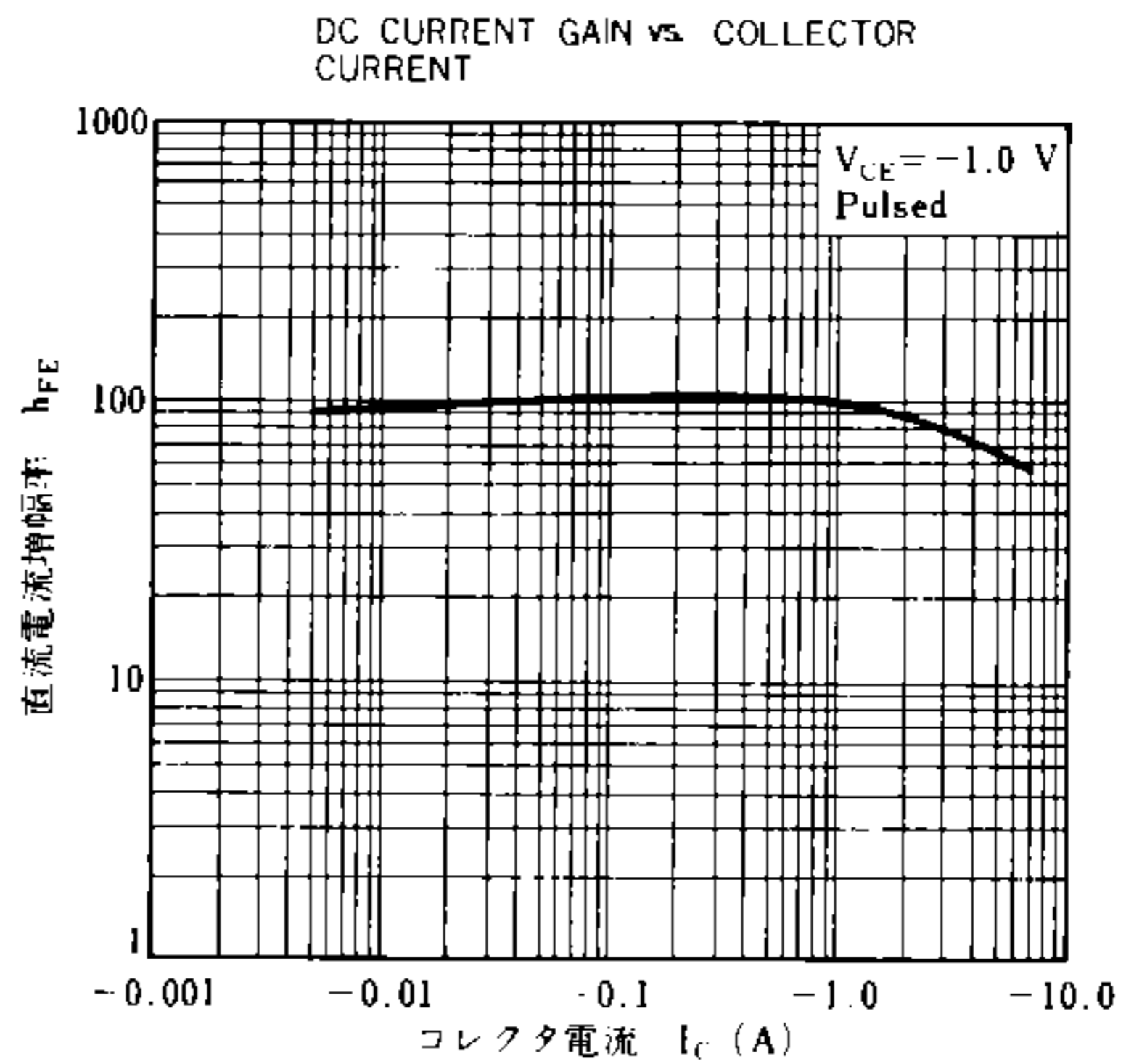
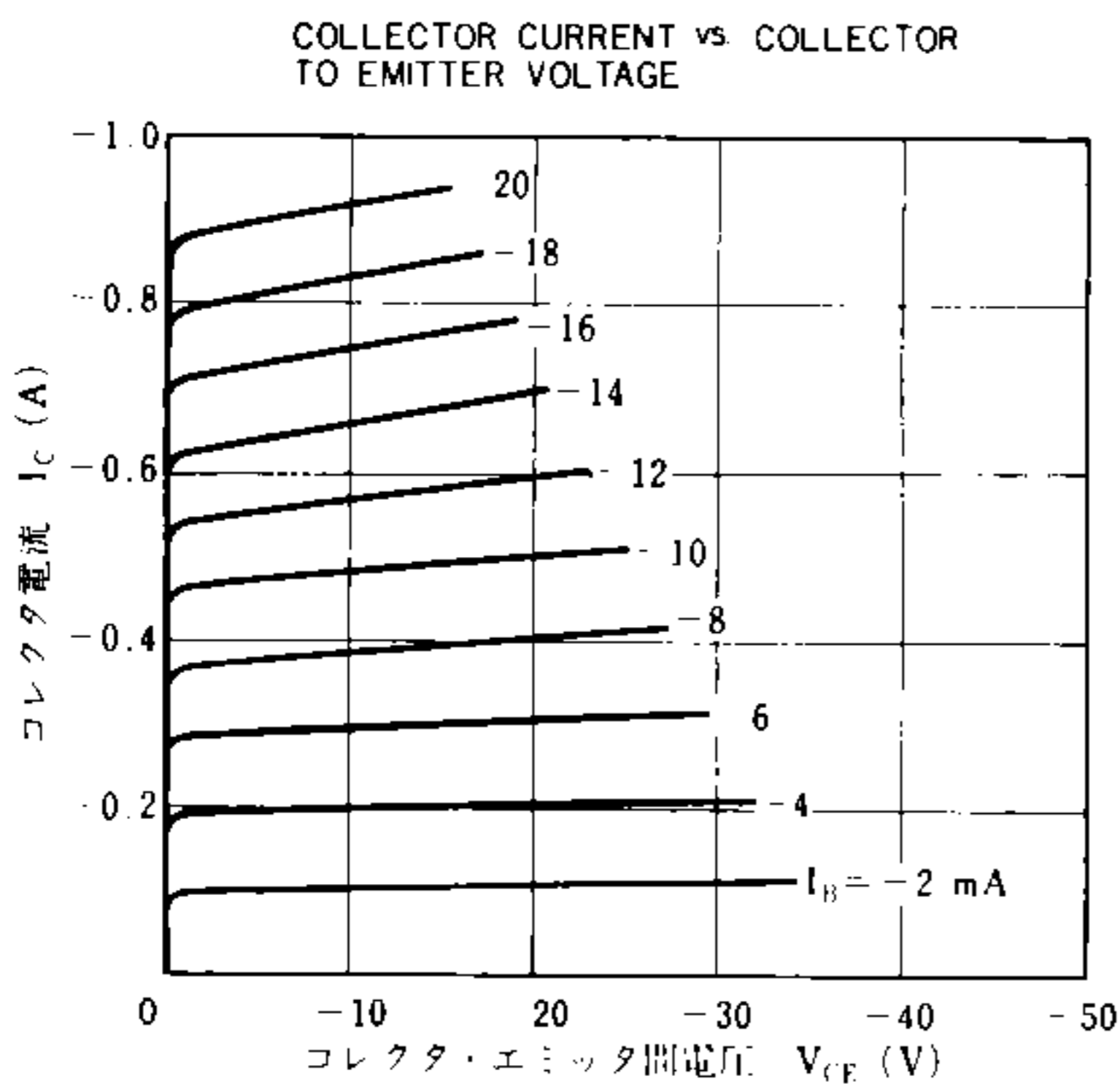
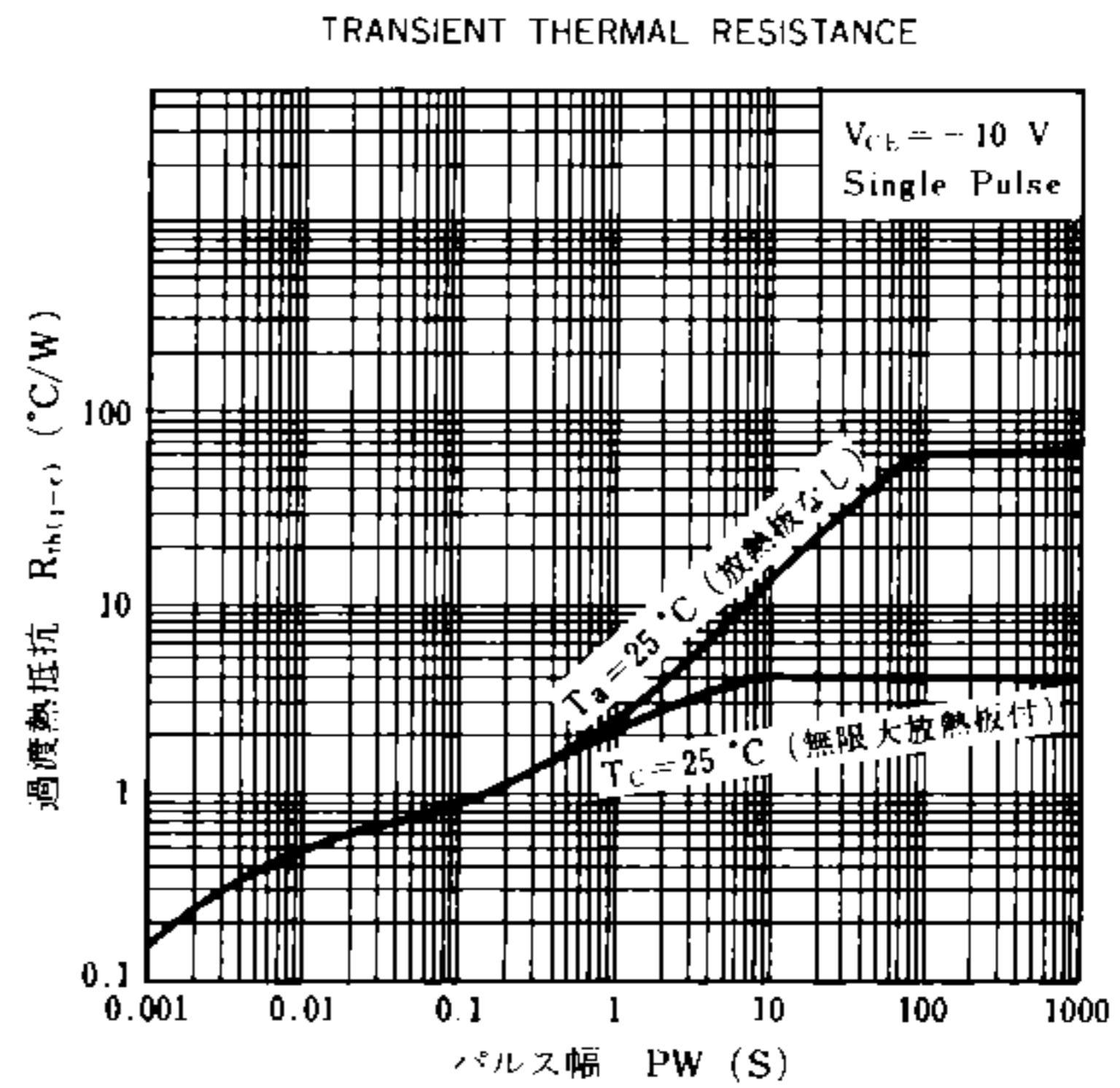
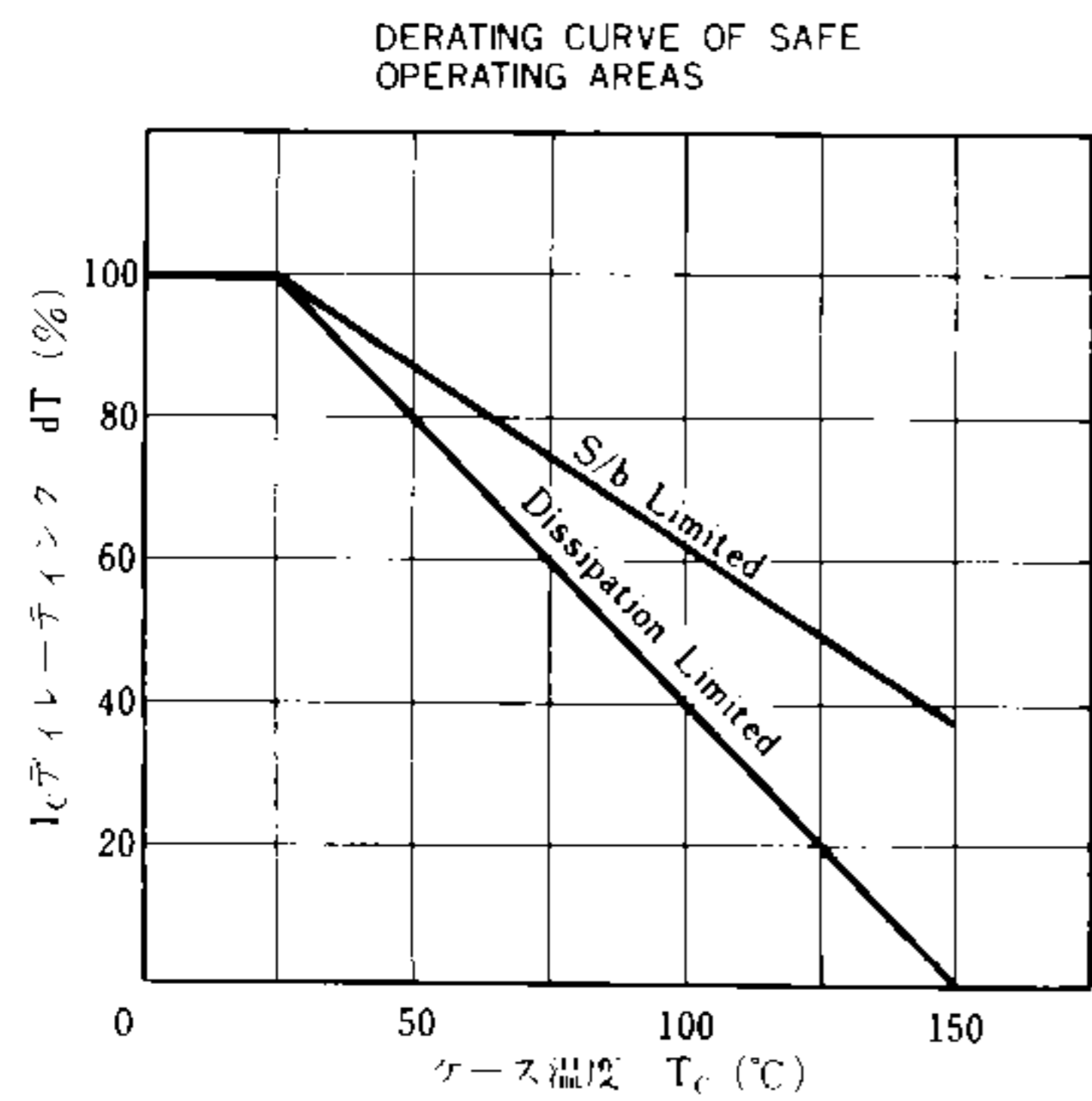
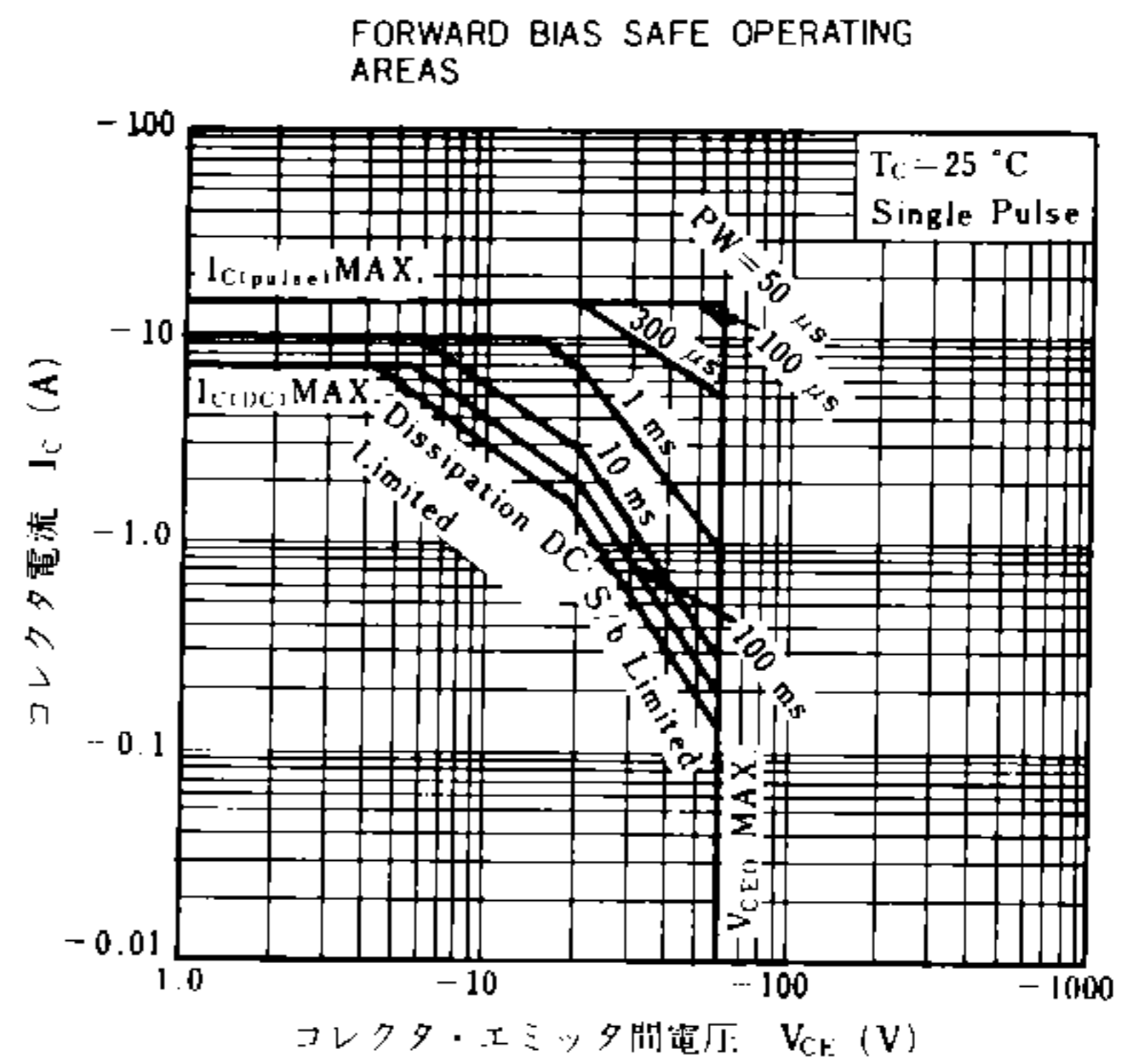
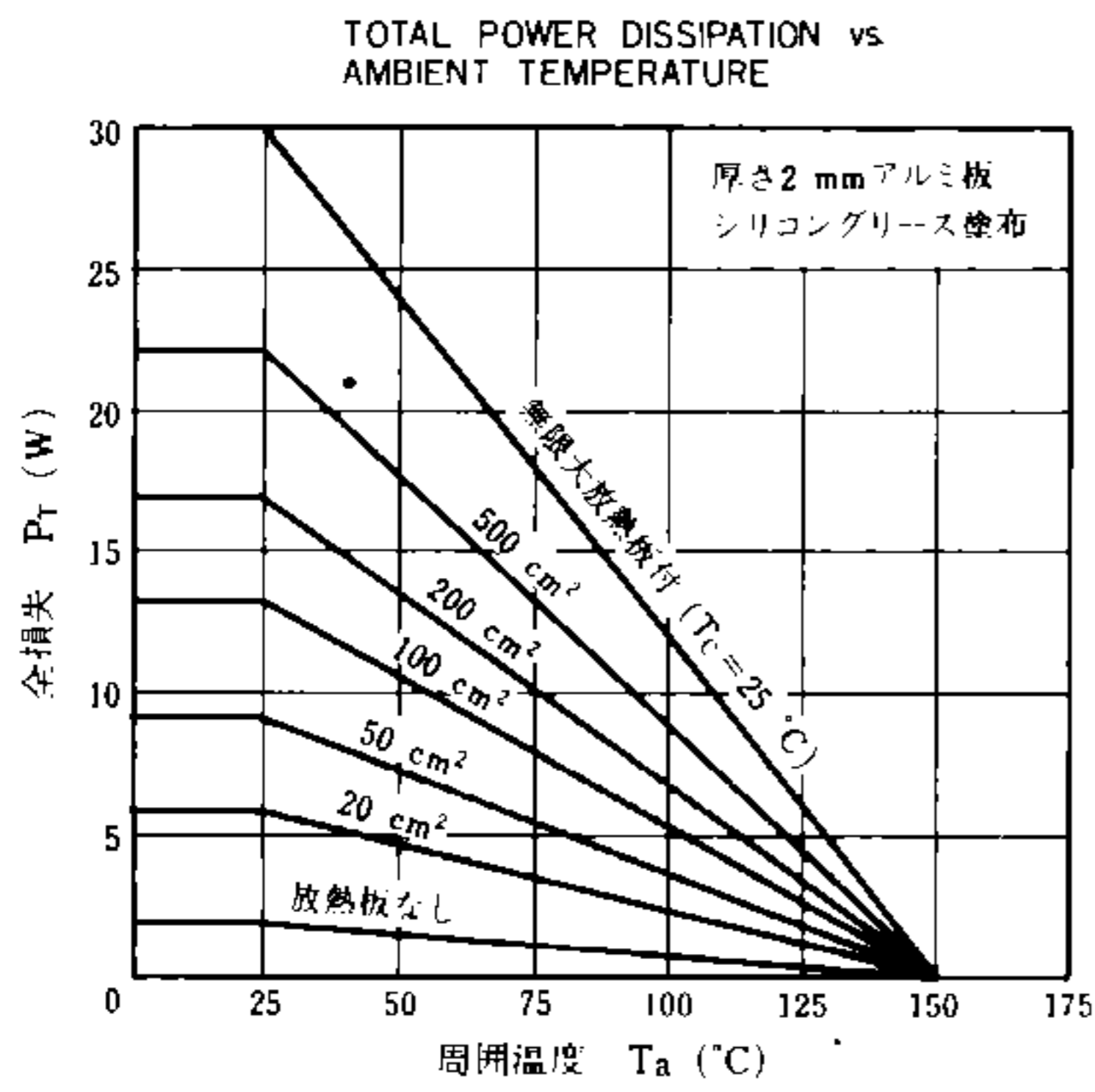
(Unit: mm)



電極接続

- ①ベース
- ②コレクタ
- ③エミッタ

特性曲線 / TYPICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)



BASE AND COLLECTOR SATURATION
VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT